

IR Chip--ORT 816IRA

1. Scope (范围) :

- This specification applies to GaAlAs/GaAlAs infrared emitting diode chips.
- 本技术条件适用于 GaAlAs/GaAlAs 红外发射二极管芯片。

2. Structure (结构) :

- Mesa Type: rough surface. 台面型: 粗糙表面
- Electrodes (电极) :
P (Anode) Side: gold alloy. P 面 (阳极) : 金合金
N (Cathode) Side: gold alloy. N 面 (阴极) : 金合金

3. Size (尺寸) :

- Top Size: $355\mu\text{m} \times 355\mu\text{m} \pm 30\mu\text{m}$; Bottom Size: $405\mu\text{m} \times 405\mu\text{m} \pm 30\mu\text{m}$
- Chip Height (芯片厚度) : $175\mu\text{m} \pm 45\mu\text{m}$
- Pad Size (电极尺寸) : $104\mu\text{m} \pm 10\mu\text{m}$
- Pattern Drawing: fig.1. 模型图: 附图 1

4. Electro-Optical Characteristics (光电性能) :

($T_a = +25^\circ\text{C}$)

Parameter 参数名称	Symbol 符号	Unit 单位	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Test Condition 测试条件
Forward voltage 正向电压	V_F	V		1.42	1.45	$I_F = 20\text{mA}$
Reverse voltage 反向电压	V_R	V	5			$I_R = 10\mu\text{A}$
Peak wavelength 峰值波长	WLP	nm		852		$I_F = 20\text{mA}$
Radiated output Power 输出功率	P_O	mw	5.4			$I_F = 20\text{mA}$

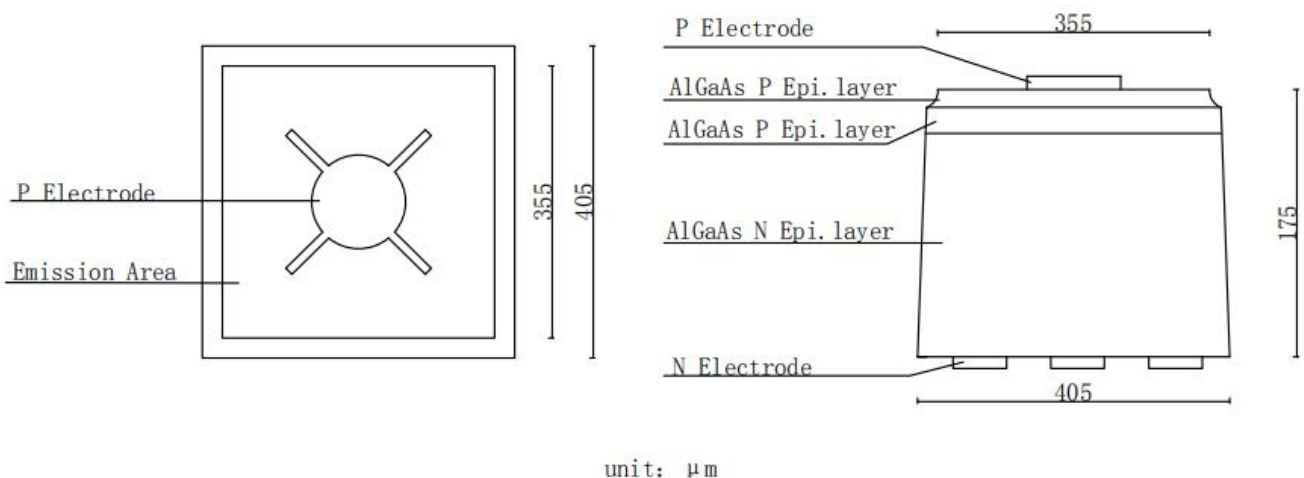


fig.1



5. Packing and Labeling（包装及标签）：

- Packing（包装）：Sheet Type 蓝膜
- Each pellet is mounted on an adhesive sheet with wire-bonded electrode side up.
每粒晶片键合电极面朝上装在粘性膜上
- Labeling（标签）：Each lot has a label sheet、writing Type、Lot No、Pcs、Avg P_O、V_F、W_{lp} and quantity of good chips.
每张芯片都附有一张注明型号、批号、张数、P_O、V_F、W_{lp} 平均值以及合格芯片数量的标签

6. Application Notes（使用说明）：

- All data are measured by Orient' s tester on bare chips within 98% of the nominal value.
所有参数均系使用奥伦德测试仪器在晶片条件下测试，98%符合标称值范围
- Measurement error for dominant wavelength and peak wavelength is $\pm 5\text{nm}$
主波长和峰值波长测量误差 $\pm 5\text{nm}$